

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 140494

ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЁТКА

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской Академии наук (КФТИ КазНЦ РАН) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2013158557

Приоритет полезной модели 27 декабря 2013 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 08 апреля 2014 г.

Срок действия патента истекает 27 декабря 2023 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов



Автор(ы): Степанов Андрей Львович (RU), Нуждин Владимир Иванович (RU), Валеев Валерий Фердинандович (RU), Галютдинов Мансур Фаляхутдинович (RU), Осин Юрий Николаевич (RU)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2013158557/28, 27.12.2013

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
27.12.2013

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 27.12.2013

(45) Опубликовано: 10.05.2014 Бюл. № 13

Адрес для переписки:

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 10/7,
Физико-технический институт Российской
академии наук, проф. Степанову Андрею
Львовичу

(72) Автор(ы):

Степанов Андрей Львович (RU),
Нуждин Владимир Иванович (RU),
Валеев Валерий Фердинандович (RU),
Галяутдинов Мансур Фаляхутдинович (RU),
Осин Юрий Николаевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Казанский физико-
технический институт им. Е.К. Завойского
Казанского научного центра Российской
Академии наук (КФТИ КазНЦ РАН) (RU)

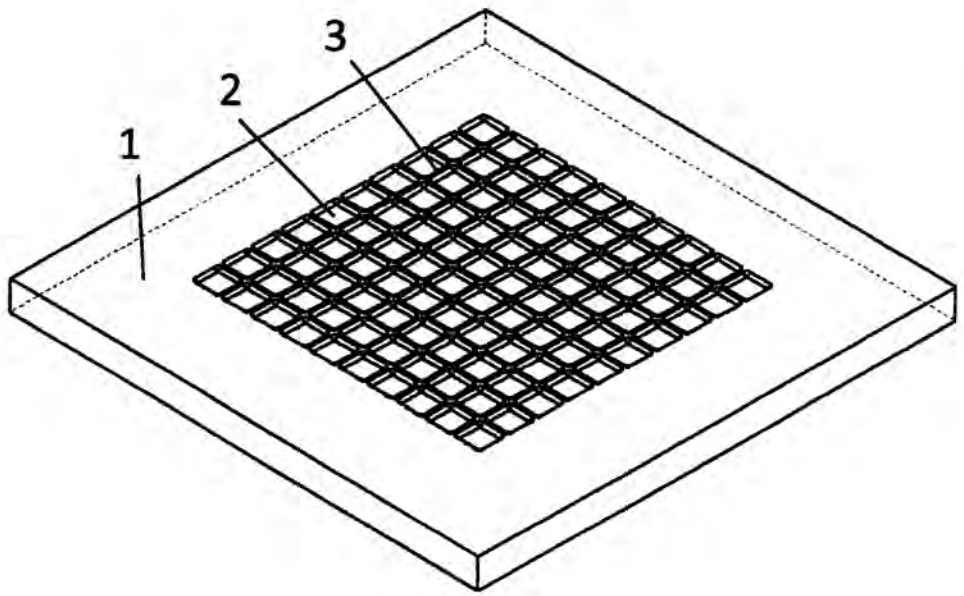
(54) ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЁТКА

(57) Формула полезной модели

Дифракционная решетка для видимого диапазона, содержащая подложку с внедрённой в её поверхность дифракционной периодической микроструктурой, элементами которой являются области, подвергнутые ионному облучению и характеризующиеся другой диэлектрической проницаемостью относительно материала подложки, отличающаяся тем, что подложка выполнена из оптически прозрачного диэлектрического или полупроводникового материала, а дифракционная периодическая микроструктура содержит ионно-синтезированные металлические наночастицы, диспергированные в приповерхностной области подложки на толщине слоя от 20 до 100 нм при концентрации металла $3 \cdot 10^{20}$ - $6 \cdot 10^{22}$ атомов/см³.

RU 140494 U1

RU 140494 U1



R U 1 4 0 4 9 4 U 1